Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 08-283708

(43)Date of publication of application : 29.10.1996

(51)Int.Cl. C09K 11/06 e036 5/06 H05B 33/14

(21)Application number : 07-089358 (71)Applicant : SHARP CORP

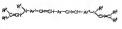
(22)Date of filing: 14.04.1995 (72)Inventor: ENOMOTO KAZUHIRO KONDO AKIHIRO

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an organic electroluminescent element useful for obtaining a luminescent body having high functions such as high luminance and high luminous efficiency, thermal stability and a long life due to high amosphousness.

CONSTITUTION: The organic electrolumenesent element prepared by laying at least an anode, a luminescent layer, an adhesive layer and a cathode on a support in the given order, wherein the luminescent layer a contains a distilbene compound represented by the formula (wherein Ar is methylene or (substituted) 6-20C arylene; Ar1 is a (substituted) lower alkyl, aralkyl or 6-14C aryl; and R2 and R3 are each H, a lower alkyl or (substituted) 6-14C aryl.



FUJII ICHIRO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-283708 (43)公開日 平成8年(1996) 10月29日

| (51) Int.Cl. ⁶ | | 藏別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | | | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|--------|
| C09K | 11/06 | | 9280-4H | C09K | 11/06 | Z | |
| G 0 3 G | 5/06 | 3 1 3 | | G 0 3 G | 5/06 | 313 | |
| H 0 5 B | 33/14 | | | H 0 5 B | 33/14 | | |

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 18 頁)

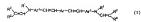
| (21)出願番号 | 特膜平7-89358 | (71)出職人 | 000005049 | |
|----------|-----------------|---------------|---------------------|----|
| | | | シャープ株式会社 | |
| (22)出顧日 | 平成7年(1995)4月14日 | | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 | |
| | | (72)発明者 | 榎木 和弘 | |
| | | | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 | シ |
| | | | ャープ株式会社内 | |
| | | (72)発明者 | 近藤 晃弘 | |
| | | | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 | シ |
| | | | ャープ株式会社内 | |
| | | (72)発明者 | 森井 一郎 | |
| | | (12,72,72 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 | *> |
| | | | ャープ株式会社内 | • |
| | | (7.4) 40-DM L | 弁理士 野河 信太郎 | |
| | | (14) 10-22/ | 月在工 到刊 自从中 | |
| | | | | |

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子および電子写真感光体素子

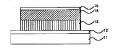
(57)【要約】

【構成】 基体上に少なくとも陽極、発光層、接着層および陰極がこの順に積層されてなり、前記発光層が式(I)

【化1】



(式中、Arはメチレン基または置換されていてもよい 6~20のアリーレン基、Ariは置換されていてもよい よいC6~20のアリーレン基、Rriは5もしくは6員 環の複素環基、置換されていてもよい低級アルキル基、 アラルキル基または70~14のアリール基、Rさまよ びR³はH、低級アルキル基または置換されていてもよ いC6~14のアリール基)で示されるジスチルベン化 合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス業子。 【効果】 高輝度、高効率等の高機能性と熱的安定性お よび高非晶性による長寿命の発光体を提供することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に少なくとも陽極、発光層、接着 層および陰極がこの順に積層されてなり、前記発光層が 式(I) 【化1】

$$R^2$$
 R^3
 $C=CH$
 $N-Ar^1-CH=CH-Ar-CH=CH-Ar^1-N$
 R^1
 $CH=C$
 R^2
 $C=CH$

(式中、Arはメチレン基または置換されていてもよい 炭素数6~20のアリーレン基、Arは置換されてい でもよい炭素数6~20のアリーレン基、Rは置機されてい れていてもよい低級アルキル基。5員環もしくは6員環 を形成する複素環基、置換されていてもよいアラルキル 基または置換されていてもよい炭素数6~14のアリー ル基、Rさは近り取ります。低級アルキル基または

置換されていてもよい炭素数6~14のアリール基を表 わす。)で示されるジスチルベン化合物を含有すること を特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 式(I)のジスチルベン化合物が、式(II)

[4:2]

(式中、R*は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル 基または低級アルコキシ基。nは1または2の軽数であ る。)で示される化合物である請求項1記載の有機エレ クトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 陽極と発光層との間に、さらに正孔注入 層が形成されている請求項1記載の有機エレクトロルミ ネッセンス素子。

【請求項4】 夢電性支持体上に、電荷発生層と電荷輸送層とをこの順で積層してなる感光層を有し、前記電荷輸送層が式(I)

[4:3]

$$R^{2}$$
 C=CH N-Ar1-CH=CH-Ar-CH=CH-Ar1-N R^{1} CH=C R^{2} (1)

(式中、Arはメチレン基または置換されていてもよい 炭素数6~20のアリーレン基、Arlは置換されてい てもよい炭素を6~20のアリーレン基、Riは置換さ れていてもよい低級アルキル基、5員環もしくは6員環 を形成する模集環基、置換されていてもよいアラルキル 基または置換されていてもよい炭素数6~14のアリー ル基、RiさよびRiは水栗原子、低級アルキル基または 置換されていてもよい炭素数6~14のアリール基を表 わす。)で示されるジスチルベン化合物を含有すること を特徴とする電子写真感光体素子。

【請求項5】 式(I)のジスチルベン化合物が、式(III)

[4:4]

(式中、Ar² はメチレン基またはフェニレン基、R⁵ は置換されていてもよい低級アルキル基。置換されてい てもよいアラルキル基または置換されていてもよい炭素 数6~140アリール基を表わす。)で示される化合物 である請求項4記載の電子写真悠光体素子。

【発明の詳細を説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機エレクトロルミネ ッセンス素子、電子写真恋光体素子に適応可能な新規ジ スチルベン化合物並びにその製造方法に関する。 【0002】

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス素子(EL素

子)は、自己発光のため根認性が高く、また空全国体業 子であり、耐傷学性に優れるという特徴を有していることから、現在、無機および有機に合物を用いた確々の素 子が提案され、かつ実用化が読みられている。これらの うち、特に、有機EL業子は印加地圧を大幅に低下させ ることができるので、各種材料、素子の開発が進められ ている。

【0003】有機EL素子の構成は、陽極/発光層/陰極を基本構成として、発光性能を向上させるために正孔 注入層、電子注入層または正孔線監層等を必要に応じて 設けることが知られている。これらのうち、発光層と陰極との間に正孔障壁層を形成する場合には、正孔障壁層を形成する場合には、正孔障壁層 のエネルギーレベルが、発光間のエネルギーレベルと異 なるような材料を用いなければならない。例えば、特開 平2-195683号公報には、発光質と降降との間 に、発光層の第一酸化電位より0.1V以上大きな第一 酸化電位を有する正孔阻止層(正孔障壁層)を設ける技 が記載をとれている。また、特開平2-195683号 公報および特開平2-255788号公報には、正孔障 壁層として8-とドロキシギノリン誘導体を用いること が記載をおたいる。

【0004】しかし、正孔線壁層として8-ヒドロキシ キノリン誘導体を用いた場合でも、青系様の発光につい では、発光効率が0.3 (1m・W・1)と低い。一方、 特額平2-242669号公報および特額平2-279 304号会報に記載されている材料を発光層に削いた場合には、青系統における高額度の発光を得ることができ るため、今後、フラットパネルディスアレイ等のフルカ ラー化に向けて有効に利用することが明持されている。 しかし、これらの材料を用いて陽低・光光層、深低一ま なは陽極、正孔注入層「発光層、深極一ま する影子を形成した場合、発光的く整系光網域を生じ ることがあるとともに、素子の寿命、微細加工等の実用 化への問題はは、未だ解決されていな。

【0005】電子写裏逃光体素子については、感光体を 形成する材料がすでにSe、ZnO、CdS等の無機系 材料から各種の有機系類料もよび染料等の有機系材料に とってかわりつつあり、その要因しては、次のような理 由が考えられる。つまり、有機系材料は、(1) 化合物 の多様性より種々の用途に応じた材料が得やすい。

(2) 蒸着をしなくても塗布方式で容易に感光体を作製 できる。(3) 安全上の問題が少ない。(4) 環境特性 が良い(特に高温高温時での劣化が少ない)。(5) 耐 大特性においても問題がない。(6) 高耐削性が得られ ている。

【0006】また、有機系材料を利用するようになった 初期の段階で、特に問題とされていた態度上の問題は、 非電性支持体上に、順次電商学生財および転寄検送層を 積層して構成される窓光体を用いることにより、いまや 完全に解消しており、特に近早は、小径化でコビー速度 の速い感光体や、高コビー速度で削コビー毎数の大きな 悠光体が来かられてきている。

【0007】機能分離型の電子写真感光体は、製造上好

ましい材料を広い範囲から選択できるばかりでなく、光 総度および耐火性を向上させることが可能な材料の選択 の幅め切いという利点をも有している。例えば、具体的 な右機を材料としては、アン面料、ベリレン面料、多環 キノン面料およびインジゴイド面料(料開閉34—13 9540号、同55—88064号、同56—4148 号、同56—14240号、同56—119131号、同63—935455号、同63—63046号、特別 平1—109352号、USP4952472号、DE -2237680、同2734288号)等、さらにピ ロロビロール化合物(USP4632893号)が挙げ られる。

【0008】感光体を構成する電荷輸送性物質として は、トルエン、ジクロルエタンまたは塩化メチレン等に 可溶なオキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、 トリフェニルアミン化合物、スチリル化合物、ヒドラゾ ン化合物およびエナミン化合物(特開平1-23628 0号公報、特開平1-226859号公報、特公平3-3 0133号公報、特公昭60-34099号公報、特開 平1-261648号公報、特開平2-272571号 公報、特開昭58-131954号公報、特開平4-1 01153号公報および特開平4-149446号公 報)が挙げられるが、これらのうちのほとんどが皮膜形 成能に乏しいために、通常バインダー樹脂が加えられ る。これら樹脂としては ポリカーボネート樹脂 ポリ アリレート樹脂、ポリエステル樹脂およびポリサルフォ ン樹脂が挙げられ、電荷輸送性物質とほぼ同量もしくは 10%程度多く使用されており、機械的劣化が少なく、 かつ輸送効率の高い(膜厚が厚くしても著しい感度低下 現象が起こりにくい。) バインダー樹脂、電荷輸送性物 質が強く求められてきている。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明着らは、有機EL 素子および電子写真感光体素子のそれぞれの課題に対応 する有機材料を合成・評価した結果、新規の構造を有す るジスチルベン化合物が有効であることを見出した。す なわち、本発明によれば、基体上に少なくとも陽極、発 光層、接着層および陰極がこの順に積層されてなり、前 記発光層が式(1)

[0010]

【化5】

$$R^2$$
 R^2
 $C=CH$
 $N-Ar^1-CH=CH-Ar-CH=CH-Ar^1-N$
 R^1
 $CH=C$
 R^2
 $C=CH$
 R^2
 $CH=C$

【0011】 (式中、Arはメチレン基または置頼されていてもよい炭素数6~20のアリーレン基、Arは 置換されていてもよい炭素数6~20のアリーレン基、 R:仁置換されていてもよい炭素水6~20のアリーレン基、 とくは合国環を形成する夜素環基、置換されていてもよい炭素数6~ 以アラルキル基または置換されていてもよい炭素数6~ 14のアリール基、R*およびR*は水素原子、低級アル キル基または置換されていてもよい炭素数6-14のア リール基を表わす。)で示されるジスチルベン化合物を 含有する有機エレクトロルミネッセンス素子が提供され る。

【0012】また、別の観点から本発明によれば、導電

可能である。) 発光機能(正孔と電子の再結合の場

を提供し、発光させることが可能である。)を有すると

ともに、上記の機能を発光につなげる発光機能等を有す

るものである。なお、正孔の注入されやすさと、電子の

注入されやすさには違いがあっても構わない。また、正

孔と電子の移動度で表される輸送機能に大小があっても

よいが、どちらか一方を移動することが好ましい。発光

層の膜厚は、特に限定されるものではないが、好ましく

は $1 nm \sim 10 \mu m$ 、特に好ましくは、 $5 nm \sim 5 \mu m$

である。発光層を形成する方法としては、例えば、蒸着

法、スピンコート法、キャスト法ままたはLB法等の公

知の方法により形成でき、特に分子堆積膜であることが

好ましい。ここで分子堆積膜とは、物質の気相状態から

沈着されて形成した薄膜や、溶液状態または液相状態か

ら固体化された膜を意味し、LB法により形成されたい

わゆる分子累積膜とは、凝集構造、高次構造の相異や、

それに起因する機能的な相異により区分することができ

る。また、この発光層は、特開昭59-194393号

公報等に開示されているように、樹脂等の結着剤を、上

記式(I)の化合物とともに溶剤に溶かした液を、スピ

ンコート法等により遠障化して形成することができる。

【0015】式(I)のArにおける「置換されていて

もよい炭素数6~20のアリーレン基」とは、P-フェ

ニレン基、m-フェニレン基、4,4-ビフェニレン

基、1、4ーナフチレン基 ターフェニレン基まかは

性支持体上に、電荷発生層と電荷輸送層とをこの順で積 層してなる感光層を有し、前記電荷輸送層が上記式

(1) で示されるジスチルベン化合物を含有する電子写 裏窓光体が提供される。本発明の有機E L素子における 基体としては、特に限定されるものではなく、例えば、 ガラス、セラミックス、硬質プラスチックス等の種々の 材質のものを使用することができ、好ましくは透明な基 板が挙げられる。

【0013】また、陽極を形成する電極材料としては、 仕事関数の大きい(4 e VDL!)金属、合金、電気伝導 性化合物およびたれらの混合物を用いることが耐まし い、このような電極材料の具体例としては、A u等の金 透明材料が率すられる。これら電極材料の限度は、特に 限定されるもかではないが、10 nm~1/km、頻まし くは10~200 nmの範囲で適宜選択することが好ま しい。陽極を形成する場合には、上記電極材料を蒸着、 スパッタリング等の公知の方法はより作製することがで る。陽極としてのシート抵制は、数百分、2以下とな るように設定することが好ましい。また、この電極より 発光を取り出す場合には、透過率が10%より大きくな るような材材を用いて作製することが好まく

【〇〇14】本売明の有機臣 L業子における発光限としては、上記式(I)の化合物を含有して形成され、通常の免光間と回線、注入機能(張圧印加時に、陽極並たは正孔法入層より正孔を注入可能であり、かか路除または電子注入周より電子を進入可能である。)、輸送機能(正孔法よび電子を電界の力により移動させることが

[0016]

[4:6]

【0017】が挙げられる。Ar! における「置換され ていてもよい炭素数6~20のアリーレン基」とは、P ーフェニレン基、mーフェニレン基、4、4ーピフェ レン基、1、4ーナフチレン基、ターフェニレン基また はこれらの基に1つまたは2つのメチル基、エチル基等 の低級アルキル基が置換されているものが挙げられる。 なかでも、材料の入手および合成上の概点からはA r お よびA r l はいずれもP - フェニレン基であることが好ましい。

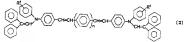
【0018】R!における「置換されていてもよい低級

アルキル基」としては、例えば、ハロゲン原子等で置換 されていてもよい直鎖または分枝の炭素数1~5のアル キル基を意味し、例えば、メチル基、エチル基、ロープ ロビル基、isoープロビル基、ブチル基、セーブチル 基、ペンチル基、クロルメチル基、クロルエチル基等が 挙げられる。「5員環または6員環の複素環基」とは、 フリル基、ビリジル基、インドリル基、インダゾリル 基、ピラゾリジル基、ピラジニル基、キノリル基、ピラ ゾリル基等が挙げられる。「置換されていてもよいアラ ルキル基」とは、ベンジル基、P-メチルベンジル基、 P-クロルベンジル基、ベンズヒドリル基、2-ナフタ レンメチレン基、9-アントラセンメチレン基等が挙げ られる。「置換されていてもよい炭素数6~14のアリ ール基」としては、フェニル基、4-ビフェニル基、ナ フチル基、2-アントリル基、P-メチレンフェニル 基、P-メトキシフェニル基、m-メチルフェニル基、 1、2-メチレンジオキシフェニル基、1-ナフチル

基、2-ナフチル基等が挙げられる。なかでも、フェニ ル基またはメトキシ基、メチル基若しくはエチル基等の 電子供与性で置換されたフェニル基が好ましい。

【0019】R² および杯² における「低級アルキル基を意味し、例えばメチル基、エチル基、 n 一プロビル基、 1 s o 一プロビル基、 ブチル基、 t ープチル基、 x がみまった。 ご腹きれていてもよい炭素数6~14のアリール基、 としては、R² におけるものと同様のものを使用することができる。なかでも、R² および杯² のいずれもがP ーメトキシフェニル基もしくはR² がメチル基かつR² がフェニル基であることが好ましい。

【0020】本発明における式(I)の化合物のうち、 好ましくは下記式(II)の化合物が挙げられる。 【0021】 【化7】



【0022】(式中、R4 は水素原子、ハロゲン原子、 低級アルキル基または低級アルコキシ基、nは1または 2の整数である。)

上記式(II) において、R⁴ の「低級アルキル基」としては、上記R⁴ と同様の低級アルキル基。「仮級アルコ キシ基」としては、炭素数1~5のアルコキシ基を意味 し、メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、ブトキシ 基、ベントキシ基が弾げられ、なかでも、メトキシ基お よびエトキシ基が好ましい。

【0023】具体的には、下記で示されるジスチルベン 化合物が射ましく、特に、式(II) の化合物である例示 化合物1、6、9、12、17、18、32がより好ま しい。

【0024】 【化8】

例示化合物2

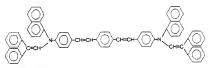
例示化合物3

例示化合物4

例示化合物5

[0025] [化9]

例示化合物7

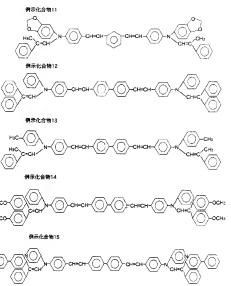


例示化合物8

例示化合物9

例示化合物10

[0026] [化10]



[他11]

例示化合物17

例示化合物18

例示化合物19

例示化合物20

[他12]

例示化合物22

例示化合物23

例示化合物24

例示化合物25

[0029] [化13]

例示化合物27

例示化合物28

[0030] [化14]

例示化合物30

例示化合物31

【0031】 例示化金物32

例示化合物33

例示化合物34

【0032】本発明における有機EL素子の接着層は、 発光層および陰極に対し付着性の高い材料を用いて形成 することが好ましい。接着層の材料としては、8-ヒド ロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体を挙げることができる。具体的には、8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノリン等のオキシンのキレートを含む金属 キレートオキシノイド化合物である。この際の接着層の 膜厚は、発光色を青系統に維持するために上記発光層の 厚さより薄いことが必要であり、好ましくは1~50 n m. 特に好ましくは5~30 nmである。この接着層 は、例えば、スピンコート法、キャスト法、蒸着法等の 公知の方法により形成することができるが、なかでも、 発光層および正孔注入層と同様、蒸着法が好ましい。 【0033】さらに、本発明における有機EL素子の陰 極としては、仕事関数の小さい(4eV以下)金属、合 金、電気伝導性化合物およびこれらの混合物等の電極材 料を用いて形成することが好ましい。このような電極材 料の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウ ム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混 合物、A1/(A12O2)、インジウム等が挙げられ る。これら電極材料の膜厚は、特に限定されるものでは ないが、10nm~1μm、好ましくは50~200n mの範囲で適宜選択することが好ましい。陰極を形成す る場合には、上記電極材料を蒸着、スパッタリング等の 公知の方法により作製することができる。また、陰極と してのシート抵抗は、数百Ω/□以下となるように設定 することが好ましい。なお、このEL素子においては、 発光を透過させることができるように、 陽極または陰極 のいずれか一方が透明または半透明であることが好まし

【0034】本発明の古機正し素子においては、必ずし も必要ではないが、発光性能の向上のため、陽極と発光 順との間に正は孔滑を設けることが解ました。この正 孔注入層を形成する材料としては、より低い電界で正孔 を発光圏に納済する材料が始ましく、正孔の移動度が1 01~10°ボルト/cmの電場で少なくとも10°°cm *ボルト・秒であることがより射ましい。

【0035】正孔注入層を形成する材料としては、例え ば、従来から光導伝材料において、正孔の電荷注入輸送 材料として慣用されているものやEL素子の正孔注入層 に使用される公知のものの中から任意のものを選択して 用いることができる。具体的には、前者の例として、シ ラザン誘導体(米国特許第4950950号明細書)、 ポリシラン系 (特開平2-204996号公報)、アニ リン系共重合体(特開平2-282263号公報)、ま た特願平1-211399号明細書で示された導電性高 分子オリゴマー、チオフェンオリゴマー等が挙げられ、 後者の例としては、トリアゾール誘導体(米国特許第3、 112,197号明細書等参照)、オキサジアゾール誘導体 (米国特許第3,189,447号明細書等参照)、イミダゾー ル誘導体(特公昭37-16096号公報等参照)、ボ リアリールアルカン誘導体(米国特許第3,615,402号明 細書、同3.820.989号明細書、同3.542.544号明細書、特 公昭45-555号公報、同51-10983号公報、 特開昭51-93224号公報、同55-17105号 公報、同56-4148号公報、同55-108667 号公報、同55-156953号公報、同56-366 56号公報等参照)、ビラゾリン誘導体およびビラゾロ ン誘導体(米国特許第3,180,729号明細書、同4,278,746 号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-8 8065号公報、同49-105537号公報、同55 -51086号公報、同56-80051号公報、同5 6-88141号公報、同57-45545号公報、同 54-112637号公報、同55-74546号公報 等参照)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第3.61 5,404号明細書、特公昭51-10105号公報、同4 6-3712号公報、同47-25336号公報、特開 昭54-53435号公報、同54-110536号公 報、同54-119925号公報等参照)、アリールア ミン誘導体(米国特許第3,567,450号明細書、同3,180,7 03号明細書、同3,240,597号明細書、同3,658,520号明細 書、同4,232,103号明細書、同4,175,961号明細書、同4, 012,376号明細書、特公昭49-35702号公報、同 39-27577号公報、特開昭55-144250号 公報、同56-119132号公報、同56-2243 7号公報、西独特許第1,110,518号明細書等参照)、ア ミノ置換カルコン誘導体(米国特許第3,526,501明細書 等参照) オキサゾール誘導体(米国特許第3,257,203 号明細書等に記載のもの)、スチリルアントラセン誘導 体(特開昭56-46234号公報等参照)、フルオレ ノン誘導体(特開昭54-110837号公割参昭) **ヒドラゾン誘導体(米国特許第3.717.462号明細書)特** 開昭54-59143号公報、同55-52063号公 報、同55-52064号公報、同55-46760号 公報、同55-85495号公報、同57-11350 号公報、同57-148749号公報、特開平2-31 1591号公報等参照)、スチルベン誘導体(特開昭6 1-210363号公報、同61-228451号公 報、同61-14642号公部、同61-72255号 公報、同62-47646号公報、同62-36674 号公報、同62-10652号公報、同62-3025 5号公報、同60-93445号公報、同60-944 62号公報、同60-174749号公報、同60-1 75052号公報等参照)等を挙げることができる。 【0036】正孔注入層は、上記化合物の1種による単 層、2種以上の組み合わせによる単層または2種以上に よる複数の積層層として、例えば、真空蒸着法、スピン コート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により成 膜することにより形成することができる。この際の正孔 注入層としての膜厚は、特に限定されるものではない が、5nm~5µmが好ましい。

【0037】次に、本発明における電子写真感光体について説明する。本発明の電子写真感光体における導電性 支持体としては、この上に電音発生層と電音輸送層とからなる感光層を形成し、感光層に電場をかけ、感光層の光吸収によって精製されたキャリア(電子または正孔)

を移動させるためのものであって、ドラム、板状体、シート等の形状の導電体を用いることができる。 導電体に 使用される材料は、例えば網、アルミニウム等の金属、 炭素、 導電性加工を施した紙またはアラスチック等が挙 げられる。

【0038】本発明の電子写真感光体における導電性支 持体の上には、電商発生間と電荷輸送網とからなる感光 層を形成を九ている。電荷発生限としては、クロロダイ アンブルー等のビスアゾ系化合物、ジブロムアンサンス ロン等の多様キン系化合物、ペリレン系化合物、キナ クリドン系化合物、フタロシアニン系化合物、アズレニ ウム塩系化合物等の材料を1種さる権以上併用して 層を形成するこかだできる。これらの材料を用いて電荷発生 層を形成する方法としては、真空蒸音で、直球化合物に よる隅を形成する方法、終可塑性の高分子バインゲーを 用いて上型電荷発生層材料をか散し、鉱布して成膜する 方法等がある。この際の電荷発生層の限厚は、0.1~ 1.0 μ和層度が終生)。

【0039】本発明の電子写真感光体における電荷輸送 層としては、上記式(I)のジスチルベン化合物を用い ることが好ましい。つまり、一般に電荷輸送層に用いる れる物質は、分子量が約200~800の低分子量化合 物のうち、特に分子量が比較的大きく、かつ共有二重結 合を有する著香族アミン化合物が安定性、感光体の感 度、オゾン等の酸化性ガスで酸化されにくく、一定の機 機的強度を有する等の性能の点で優れていることが知ら れているからである。 上記式 (I) のジスチルベン化合 物は、単独では皮膜形成能に乏しいため、熱可塑性の高 分子バインダーをほぼ同量加えて、電荷輸送層を形成す ることが好ましい。この際の熱可塑性の高分子バインダ ーとしては、ボリカーボネート樹脂、ボリアリレート樹 脂、ポリエステル樹脂等のエステル系樹脂を使用するこ とができる。電荷輸送層の厚さは、特に限定されるもの ではなく、適宜状況に応じて選ぶことができるが、好ま しくは、 $5\mu m\sim 30\mu m$ である。この電荷輸送層に用 いられる式(I)のジスチルベン化合物のうち、式(II I)

【0040】 【化16】

【0041】(式中、Ar² はメチレン基またはフェエン基、R² は匿換されていてもよい低機アルキル基、 置換されていてもよいアラルキル基または置強されてい でもよい炭素数6~14のアリール基を表わす。)で売 される化合物が断ましい、式(III)のR² における「置 換されていてもよい低級アルキル基、置換されていても よいアラルキル基または置換されていてもよい炭素数6 ~14のアリール基」は、上記式(I)のR² で定義さ れているもの同様のものが挙げられる。

【0042]また、式(1)のジスチルペン化合物を電 子写真窓光体素子に用いる場合には、通常、これらジス チルベン化合物を有機溶解に新能して用いる場合が多い ため、溶解性の悪い、比較的高酸点のジスチルペン化合 物は好ましくない。この際の有機溶媒としては、アセト ン、メチルエチルケトン等のケン類、簡単エチル、酢 酸ブチル等のエステル類、テトラヒドロフラン、ジオキ サン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン等の芳香飯段 化木雲類 N、Nージメチルボルムアミド、ジメチルス ルホキンド等の邦プロ『ン仕橋性溶媒素が挙げられる。 溶解性の良好な化合物としては、式(1)の化合物において、Arがメチレン基、mーフェニレン基、3,5 ー ジメチルーPーフェニレン基等であり、R*1 は低級アル キル基、電子供与基で置換されたフェニル基、R*1 およ びド?はいずれもフェニル番もしくはド?およびド?の いずれか1つがメチル基、他方がフェニル基の化合物が 挙げられる。

【0043】具体的には、式(1)のジスチルベン化合物として示した下記の化合物のうち、特に、式(11)の 危合物である例示(合物)、7,9、12、2010の も合物である例示(合物)、7,9、12、2010の 30がより好ましい。本発明に利用される新規ジスチル ベン化合物は、下記合成経路により容易に合成すること かできる。

【0044】つまり、式 (IV)

【0045】 【化17】

R1-H-Ar1-CH=CH-Ar-CH=CH-Ar1-N-R1

【0046】 (式中、記号は式(I)と同義である。) で示される化合物を、式(V) 【0047】 【化18】

【0048】(式中、記号は式(I)と同義である。) で示される化合物と1:2から1:2.5のモル比でベ ンゼン、モノクロルベンゼン、酢酸エチル、トルエンま たはエタノール等の溶剤中において反応させ、さらにP ートルエンスルホン酸、オフタレンスルホン酸、塩酸ま たは酢酸等を少量加え、加熱・生成した水を系外に除く ことにより容易に合成することができる。

【0049】また、別の合成経路によっても新規ジスチ ルベン化合物を合成することができる。すなわち式(V

【化19】

$$R^{2} C = CH^{N-Ar^{1}-CHO}$$
 (VI)

【0051】(式中、記号は式(I)と同義である。) で示される化合物を、式(VII)

[0052]

【化20】

【0053】(式中、Rは上記と回義、他の記号は式 (1)と同義である。)で示される化合物と2:1から 2.5:1のモル比で、ジメチルホルムアミド、ジメチ ルスルホオキサイド、ジメチルアセトアミド、エタノー ル等の溶剤中で反応させ、さらに、ナトリウムエトキサ イド、カリウムーセェトセーアトキサイド等で表で、(VII) の化合物とはは等モル加え、室温下もしくは70~10 0℃の界温下で反応させることにより容易に合成することができる。

[0054]

[0054]

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明する。 合成例 1 (例示化合物 1 の合成)

1-a) 1, 1-ジフェニル-2-(ジフェニルアミノ) エチレンの合成

ジフェニルアミン32g及びジフェニルアモトアルデヒド36.0gをベンゼン約40回に溶解する。これに 20gのロートルエンスルホン酸を加え、加熱し、反応により生する水を系外に除く。ベンゼン等を除去した後、折組した白色粉末を削削エチルより再結晶化し、白色結晶56gを得る。融点は149.0~150.0℃であった。

1-b)1,1-ジフェニル-2-(ジフェニルアミノ)エチレンのモノアルデヒド体の合成

1 ー a) で合成したエナミン化合物10 まをジクロロエ タン2 の山に溶解し、これをオキシ塩化リン8、9 g (5. 4 m) とジメチルホルムアミド5、6 gにより調 合したビルスマイヤー試集中に徐々に水冷下加えた後、 水冷下、窓部下、加熱下(内線80~85で)と徐々に 反応温度を上げて反応を行なう。木反応液を5 N ー N a 〇日水中に加え、反応後を弱アルカリ権にした後、ジク 미ロエタシャロに溶解した目的物を取り出し、責白色の粉 末状結晶9.1gを得る。融点は145.0~145. 5℃であった

【0055】また、本化合物のIRを測定(KBr統利法)した結果、1730cm¹付近にアルデヒド基の吸収が認められた。

1-c)p-フェニレン基含有リン化合物の合成

α、α、一ジクロルーp ― キシレン4、5 gと 亜リン酸 トリエチル1 1 g を登業気流下、オイルバス中 「温度1 3 GC) で6 時間加熱模拌を存なった。次に連続の乗り ン酸トリエリル及び副生成した環化エチルを減圧密去した。これをエーアル中で放置すると自色粉末7、2 gを 停る、龍点は68、5 ~ 70、0 g できかった。

1-d)例示化合物1の合成

1-c)で得た明ttis化合物1.3gと1-b)で得た アルデヒド化合物5.0gとをジメチルホルムアミド5 の回に溶解し、これに室温下、tertーブトキシボタ ウル1.5gを徐々にスパチラより加え、2割間配拌 を行なった。新出した強い電光を有する黄色粉末を取り 出し、次いで熱アセトンで十分洗浄を行ない、2.3g のN、N、-ジエナミン基金有ジスチルベン化合物を得 る。観点は248.5~250.5℃であった。

【0056】本化合物のIRを測定(KBr錠剤法)した結果、1520cm⁻¹、1620cm⁻¹にメチリディンに基づく吸収が認められた。

合成例2(例示化合物6の合成)

2-a) 1-フェニル-1-(4'-メトキシフェニル)-2-(ジフェニルアミノ) エチレンの合成

フェニル (4-水トキシフェニル)アミン208及び ジフェニルアセトアルドと1度をベンゼン300mi に溶解させる。これに15msのpートルエンスルホン酸 を加えて加熱し、反応により生ずる水を条外に除く、ベ ンゼン等を除去後メタノール100mi中で加熱温流を行 なうと自色的木が削出する。この粉末を削減エチル:メ タノールより再結晶化を行ない、自色の結晶23、4g を得る。随点は18~120であった。

2-b) 1-フェニル (4-メトキシフェニル) -2-(ジフェニルアミノ) エチレンのモノアルデヒド体の合成

2-a) で合成したエナミン化合物12gをジタロルエ タン20mに溶解し、これをオキシ塩化リン8、9g 合したビルスマイヤー試薬中に徐々に火冷下加えた後、 水冷下、次いで空温下、加熱下(内温80~85℃)と 徐々に反応滅度を上げて行き、反応を行をった。最後に 反応液を5N-NaOH水溶液中に加え、水電を弱アル カリ性にした後、ジクロロ20ツーに溶解した目的物を 取り出し、前截エチルより再結晶を行ない。自他の粉末 状結晶9、4gを得る。能点は112.5℃~114.

2-c)例示化合物6の合成

1-c) で金成したpーフェニレン基合有リン化合物 2.1 gと2-b) で合成したモノアルデモド降9.0 gをジメチルルグミド100mlに溶解し、これに室 温下、tertーブトキシボタシウム2.5gを徐水に スパチラより加え、2時間照样を行なった。析出した施 切覚光を有する黄色粉末を取り出し、次いでアセトンで 十分洗浄を行ない4.1 gのN、N'ージエナミン基合 有ジステルベン化合物を得る。健原は234.5~23 6.5℃であった。

【0057】本化合物のIR測定でも、例示化合物1と 同様に1520cm⁻¹及び1620cm⁻¹付近にメチリ ディン基に基づく吸収が認められた。

合成例3(例示化合物3の合成) 3-a)1,1-ジフェニル-2-ジ(p-メトキシフ

3-a) 1, 1-ジフェニルー2-ジ(p-メトキシン ェニル) アミノエチレンの合成

ジフェニルアミン32g及びジ(p-メトキシフェニル)アセトアルデヒド42gをベンゼン約500mlに静 解する。これに20mgのpートルエンスルホン雄20mg を加え、ディーンスターク管により反応の結果生ずる水 を系外に除く、ベンゼン等を除去した後、折乱した白色 粉末をメタノールで洗浄し、酢酸エチルより再結晶化し て白色結晶589gを得る。

3-b) 1, 1-ジフェエルー2-ジ (p-メトキシフェニル) アミノエチレンのモノアルデヒド体の合成 1-b) と同様の合成方法により、下記式に示す黄白色 の結晶を得る。 酸点は125、5~127、0℃であっ

【0058】 【化21】

【0059】3-c)例示化合物3の合成

1 - d) と同様の合成方法により、強い強光を有する責 値色結晶を得る。ジメチルホルムアミドによる熱洗浄に よって、目的物を精製した、飛点は254.5~25 7.0できった。本化合物の1 R線定でも例示化合物 1と同様に1525cm¹及び1630cm¹付近にメ チリディン基に基づく吸収が遅められた。

合成例4(例示化合物12の合成)

4-a) ビフェニレン基含有リン化合物の合成

4, 4' - ビス (クロルメチル) ビフェニル7.0 gと 亜リン酸トリエチル1 gとを、 N_2 気流下、オイルバス 中、5時間加熱震流を行った。

【0060】過剰の亜リン酸トリエチル、副生成物の塩 化エチル等を減圧留去した後、析出した下記式の白色結 品8.4gを得た。 献点は98~100.5℃であっ た。 【0061】 【化22】

【0062】なお、この化合物は、バイルシュタインテ ストにおいて負を示し、ハロゲンは含まれていないこと が判った。

4-b) 例示化合物 12の合成

4-a)で得欠地社は配合物4.2 gと1-b)で得た 生ノアルデヒド体7.5 gをジメチルホルスアミド50 山に溶解し、これにボタシウムーセロ・ヒーブトキサイ ド2.4 gを徐々に加え、室温下4時間続手した、折出 した強い強光を打する積色粉末を取り出し、十分水洗 後、熱アセトンで十分洗浄を行ない積色粉末6.5 gを 滑た、視点は287.5~289.5であった。 金成倒く個水量や動1.40分岐

4-a) で得た時はは化合物4.2gと3-b)で得た モノアルデヒド体5.3gをジメチルホルムアミド50 町に溶解し、これにボタシウムトロ・ヒ・エードキサイド 2.4gを徐々仁加え、電温下4時間報件した。折出し た強い電光を有する報色粉末を取り出し、十分水洗後、 熱アセトンで洗浄を行ない強い理色の光性6.7gを 得た。混成は293.5c295.5cであった。 金庫解ら(阿不耐全物29の分金度)

6-a)メチレン基含有リン化合物の合成

1,3-ジブロモプロパン10gと亜リン酸トリエチル 20gを、N:気液下、オイルパス中で5時間が熟湿液 した、透刺の亜リン酸トリエチル等を減圧留去し、更に 減圧情製することにより下記式の油状の無色透明物質7 gを得た。

[0063]

【化23】

15O)2 P CH2-CH2-CH2 P(OC2H5)2

【0064】6-b) 例示化会物29の合成 6-a)で得た時社は8化合物2.8 gと1-b)で得た セノアルデヒド係8.0 gをジメチルホルムアミド20 ■に溶解し、これにナトリウムエチラートのアルコール 溶液を徐々に加え、室温下4時間短件を行なった。後一 枚減減後、反泛液中に水100回を加え、折出したアメ 水体物を酢酸エチル50回より抽出し、十分股水した。 ■中で加熱透流すると、徐々に質白色粉末が生成する。 生成した粉末を取り出し、ベンゼン: nーヘキサンによ りカラム分離することにより未反応のモノアルデヒド体 と分離を行なう。

【0065】メタノールで熱洗後、3.6gの蛍光性を 有する黄色味の強い粉末を得た。融点は145.5~1 47.0℃であった。 合成例7 (例示化合物1の別法による合成)

7-a) ジフェニルアミンのモノアルデヒド体の合成 N-アリルジフェニルアミンのアルデヒド40gを酢酸 エチル400mlに溶解し、これに1N-塩酸水溶液10 Onlを加え、室温下激しく2時間撹拌する。加水分解に 伴ない酢酸エチル層は黄色溶液から緑色溶液に変化す る。次いで、酢酸エチル層を無水硫酸ソーダより脱水し た後、酢酸エチルを留去して残留物をエーテルより再結 品し、下記式の緑白色の粉末26gを得る。融点は5 0~54.5℃であった。

[0066] 【化24】

【0067】7-b) 例示化合物1の合成

7-a)のモノアルデヒド体4.0gと1-c)で合成 した含有リン化合物2.1gを2-c)と同様にしてジ スチルベン化合物4、2gを得る。このジスチルベン化 合物に2.2倍モルのジフェニルアセトアルデヒドを加 ジクロルベンゼン中少量の無水酢酸を加えて 加熱 脱水化することにより例示化合物1を得る。

【0068】合成例1の化合物と合成例7の化合物を少 量づつ混ぜ合わせて毛細管につめ、融点の低下現象を観 零したが、せったく低下現象は認められなかった。ま た、IR測定を行なったが、スペクトルはまったく同一 であった。

実施例1~5 有機エレクトロルミネッセンス素子 図1に示したように、厚さ1.1mmのガラス基板11上 にITO12を0、 1μ の厚さで蒸着したものを、透明 支持基板として用いた。この透明支持基板をイソプロビ ルアルコール中、次いで純水中で超音波洗浄し、最後の UVオゾン洗浄を行なった。

【0069】このガラス基板11を蒸着装置(日本真空 技術(株)製)のホルダーに固定し、モリブデン製の抵 抗加熱ボートにN, N'-ビス(3-メチルフェニル) -N, N' ージフェニル〔1, 1'ーピフェニル〕(T

PD) (イオン化エネルギー: 5,85eV)を200

mgを入れ、さらに別のモリブデン製ボードに、表1に 示した例示化合物1、3、6、12及び22を200m g入れ、次いで、真空槽を1×10-1Paまで減圧し た。その後、TPD入りの前記ボードを215~220 でまで加熱し、TPDを蒸着速度1~0.3 nm/se cでITO12上に蒸着して、膜厚0,06μの正孔注 入層13を形成した。

【0070】続いて、得られたガラス基板11を真空槽 より取り出すことなく、正孔注入層13の上に、表1に 示した例示化合物1、3、6、12及び22が入ったボ ートから、0.04μmの膜厚を有する発光層14を積 層素着によって形成した。蒸着条件は、ボート温度が3 30℃、蒸着速度は0.1~0.3nm/sec、基板 温度は室温であった。

【0071】次いで、得られたガラス基板11を真空槽 より取り出し、発光層14の上にステンレススチール製 のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定した。次に モリブデン製ポードにトリス (8-キノリノール) アル ミニウム (Alq₃)を200mg入れて真空槽に載置 した。また、別のモリブデン製のボートにマグネシウム リボン1gを入れ、さらに別のタングステン製バスケッ トに銀ワイヤーを500mg入れた。その後、真空槽を 1×10⁻⁴Paまで減圧してから、Alq。の入ったボ ートを230℃まで加熱し、A1 q。を0.01~0. 03nm/sの蒸着速度で発光層14上に0.02μ基 着するとともに、同時に銀を0、1 nm/sの蒸着速度 で抵抗加熱法により、さらに別のモリブデン製ボートか らマグネシウムを1.4nm/sの蒸着速度で蒸着し た。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光 層の上に1,5μm積層蒸着し、降極15を形成した。 【0072】このようにして作製した有機エレクトロル ミネッセンス素子の陽極12と陰極15との間に15V の電圧を印加した時の最大発光輝度および最大発光頻度 の半減時間を測定した。その結果を表1に示した。な お、表1のデータは、資料を真空中に置いて測定したも のである。 [0073]

【表1】

事牌制 発色体材料 最大発光輝度(cd/m²) 半減時間(分) 1 例示化合物 1 4400 120 2 3 6000 90 3 6 5600 280 4 12 7800 110 22 9600 160

【0074】実飾例6~10 電子写真感光体素子 導電性支持体23として、75µmの膜厚のボリエステ ルフィルム21上に、膜厚10μmのアルミニウム膜2

2を蒸着した。また、オキシチタニウムフタロシアニン 5gをジメトキシエタン100gに加え、サンドグライ ンド処理した後、ボリビニルブチラール樹脂 (電気化学 工業(株)製、商品名:電化プチラール #6000C) 3度をジメトキシエタン50gに溶解した溶液に加え、 分散液を得た。この液を上記薄電性支持体23上に、乾 (機合の膜厚が0.4µmになるように塗布し、電荷発生 層24を形成した。

【0075】電荷輸送性物質として表2の例示化合物 1、2、5、24および29を各10g、ポリカーボネ ート機脂(三菱ガス化学,2400)10gとおよびビ タミンE0、28をジオキサン100m1に溶解した溶 液を測製し、この溶液を、電荷発生層24上に、乾燥検 の限厚が23μmとなるように達布し、電荷輸送層25 を形成してサンブルを作成した。

【0076】このようにして作成されたサンプルの電子

写真料性を静電放客艦試験表間 (川口電気製、SP-4 28) を用いて評価した。その結果を表えに示す。表2 の常電圧は、コロナ電流が22μAになるように電圧を 印加することにより負帯電した場合の電位であり、感度 は1、0ルクスの白色光を開始した第の表面電圧が う00Vから-250Vに半減するに要した除電電光量で あり、残留電位は繋光から10秒後の電位である。ま た、1万間後の電子写真特は、内陸数を目がて1万回 の空エージング試験を行いった場合の常電圧および残留 電位である(満光量:20ルックス×1秒)。

【表2】

| 実施例 | 電荷輸送性 化合物 | | | 初期特情 | 1万回後の特性 | | |
|-----|--------------|---|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 帯電圧 (V) | 感度 E1/2(luxsec) | 残留電位 (V) | 帯電圧 (V) | 残留電位 (V) |
| 6 | 例示化合物 | 1 | -710 | 0.12 | 0 | -685 | -3 |
| 7 | " | 2 | -705 | 0.11 | 0 | -685 | -5 |
| 8 | " | 3 | -680 | 0.15 | 0 | -640 | -3 |
| 9 | " | 4 | -715 | 0.10 | 0 | -695 | -14 |
| 10 | ,, | 5 | -640 | 0.10 | 0 | -625 | -5 |

[0078]

【発明の効果】本発明の有機エレクトロルミネッセンス 素子の発光密および電子享集&光体素子の電荷輸送層 に、特定の新規な構造を有するジスチルベン化合物を用 いた場合には、優れた性能を示す。つまり、有機エレク トロルミネッセンス素子として用いた場合には、高輝 度、高効率等の高機能性と熱的安定性および高非晶性に よる長寿命の発光体を提供することができる。

【0079】また、電子写真感光体素子として用いた場合には、優九たホール純送物車(〜10¹⁴cm²/V)を有し、光劣化、熱的終化さよび機械的劣化の少ない高感度、高層制用感光体を提供することができる。 【図面の原理な製明】

【図1】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の

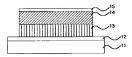
実験例を示す概略断面図である。

【図2】本発明の電子写真感光体の実施例を示す機略断面図である。

【符号の説明】

- 11 ガラス基板
- 12 ITO(陽極)
- 13 正孔注入層
- 14 発光層
- 15 金属電極層
- 21 ポリエステルフィルム22 アルミニウム膜
- 2 /// 22/2
- 23 電荷発生層
- 24 電荷輸送層

[31]



[X2]

